

MOS 形電界効果パワートランジスタ  
MOS Field Effect Power Transistor

# 2SJ142

P チャネルパワー MOS FET  
スイッチング用  
工業用

2SJ142 は、P チャネル縦形パワー MOS FET で、5V 電源系 IC の出力による直接駆動が可能な高速スイッチングデバイスです。  
オン抵抗が低く、スイッチング特性も優れているため、モータ、ソレノイド、ランプの制御に最適です。

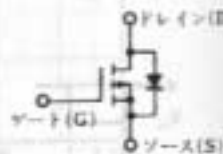
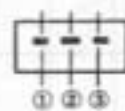
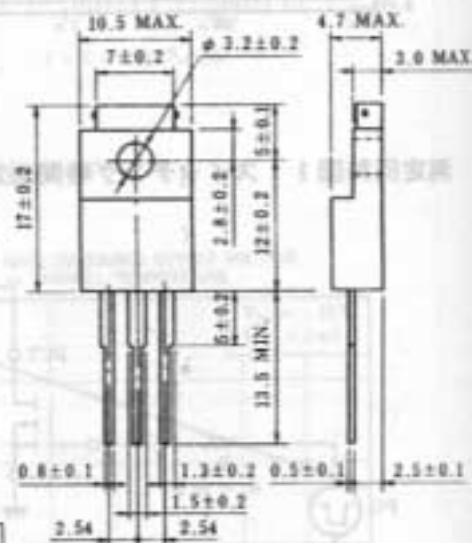
特 徴

- 低オン抵抗です。  
 $R_{DS(on)} \leq 0.2 \Omega$  @  $V_{GS} = -10V, I_D = -10A$   
 $R_{DS(on)} \leq 0.3 \Omega$  @  $V_{GS} = -4V, I_D = -8.0A$
- 4V 駆動です。
- インダクティブ負荷において保護回路なしで動作可能です。

絶対最大定格 ( $T_a = 25^\circ C$ )

項 目	略号	条 件	定 格	単 位
ドレイン・ソース間電圧	$V_{DSS}$	$V_{GS} = 0$	-100	V
ゲート・ソース間電圧	$V_{GSS}$	$V_{DS} = 0$	$\pm 20$	V
ドレイン電流(直 流)	$I_{D(DC)}$	$T_C = 25^\circ C$	$\mp 13$	A
ドレイン電流(パルス)	$I_{D(pulse)}$	$PW \leq 100 \mu s$ Duty Cycle $\leq 2\%$	$\mp 52$	A
全 損 失	$P_T$	$T_C = 25^\circ C$	35	W
全 損 失	$P_T$	$T_a = 25^\circ C$	2.0	W
チャネル温度	$T_{ch}$		150	$^\circ C$
保 存 温 度	$T_{stg}$		-55 ~ +150	$^\circ C$

外形図 (単位: mm)



- 電極接続
- ① Gate
  - ② Drain
  - ③ Source

(上図中のダイオードは寄生ダイオードです。)

